

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2012-73640

(P2012-73640A)

(43) 公開日 平成24年4月12日(2012.4.12)

(51) Int.Cl.

G02F 1/1343 (2006.01)

F 1

G O 2 F 1/1343

テーマコード(参考)

2 H O 9 2

審査請求 有 請求項の数 5 O L (全 21 頁)

(21) 出願番号 特願2011-259628 (P2011-259628)
 (22) 出願日 平成23年11月28日 (2011.11.28)
 (62) 分割の表示 特願2009-92113 (P2009-92113)
 の分割
 原出願日 平成12年10月31日 (2000.10.31)

(71) 出願人 000005049
 シャープ株式会社
 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
 (74) 代理人 110000338
 特許業務法人原謙三国際特許事務所
 (72) 発明者 仲西 洋平
 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
 1号 富士通株式会社内
 (72) 発明者 吉田 秀史
 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
 1号 富士通株式会社内
 (72) 発明者 笹林 貴
 神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番
 1号 富士通株式会社内

最終頁に続く

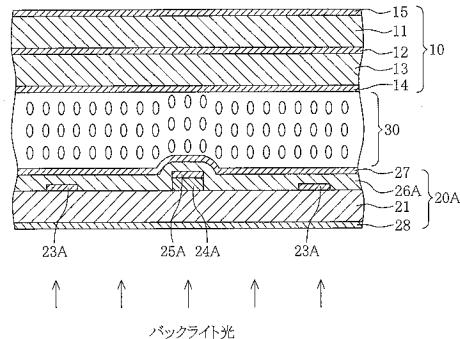
(54) 【発明の名称】 液晶表示パネル

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 焼付率を低減可能な構造の液晶表示装置を提供する。

【解決手段】 透明絶縁基板11, 21の間に液晶30が封入され、透明絶縁基板21の液晶30に対向する面に形成された画素電極25A及びコモン電極23Aを有する液晶表示パネルにおいて、画素電極25Aとコモン電極23Aとが第2絶縁膜24Aを介して重なり合う部分を有し、第1絶縁膜26Aは、上記画素電極25A上と上記コモン電極23A上で厚みが実質的に同一である。

【選択図】 図1 6



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

第1基板と第2基板との間に液晶が封入され、上記第1基板は、絶縁基板と、上記絶縁基板の上方に形成された画素電極及びコモン電極と、上記画素電極と上記コモン電極とを被う第1絶縁膜とを有する液晶表示パネルにおいて、

上記絶縁基板の液晶側の面を基準として、上記画素電極の位置が上記コモン電極の位置よりも高く、上記画素電極と上記コモン電極とが第2絶縁膜を介して重なり合う部分を有し、上記第1絶縁膜は、上記画素電極上と上記コモン電極上で厚みが実質的に同一である、ことを特徴とする液晶表示パネル。

【請求項 2】

上記コモン電極は、上記絶縁基板上に形成され、上記画素電極は、上記コモン電極が形成された後に第2絶縁膜を介して形成され、上記第1絶縁膜は、上記画素電極の下方の部分以外の上記第2絶縁膜が除去された後に形成されている、ことを特徴とする請求項1記載の液晶表示パネル。

【請求項 3】

第1基板と第2基板との間に液晶が封入され、上記第1基板は、絶縁基板と、上記絶縁基板の上方に形成され絶縁膜を介し互いに交差する部分を有する画素電極及びコモン電極とを備えた液晶表示パネルにおいて、上記画素電極及び上記コモン電極はいずれも、上記交差部分と連続する互いに平行な線電極部分を有し、上記交差部分の上記画素電極と上記コモン電極の隣り合う辺が互いに鈍角で交差している、ことを特徴とする液晶表示パネル。
20

【請求項 4】

高さ方向を無視した平面上について、上記交差部分の上記隣り合う辺が、上記平行線分の間を通る直線に関し実質的に対称であることを特徴とする請求項3記載の液晶表示パネル。

【請求項 5】

上記交差部分の上記隣り合う辺のいずれについても、上記絶縁基板の上下方向に関し上記画素電極の辺と上記コモン電極の辺とが重なっていないことを特徴とする請求項3又は4記載の液晶表示パネル。

【発明の詳細な説明】**【技術分野】****【0001】**

本発明は、焼付率を低減可能な構造の液晶表示パネルに関する。

【背景技術】**【0002】**

図31及び図32はいずれも液晶表示パネルの1画素の構造を示す概略断面図である。図31は電圧無印加時の状態を示し、図32は電圧印加時の状態を示す。

【0003】

液晶表示パネルは、互いに対向する基板10及び20と、これらの間に封入された、正の誘電率異方性を有するネマティック液晶30とを備えている。基板10では、透明絶縁基板11、例えばガラス基板の一面に、面電極12、誘電体13及び垂直配向層14が積層され、透明絶縁基板11の他面に偏光子15が被着されている。基板20では、透明絶縁基板21、例えばガラス基板の一面に、コモン電極23が形成され、その上に絶縁層24を介して画素電極25が形成されている。絶縁層24及び画素電極25の上には、絶縁層26及び垂直配向層27が積層されている。透明絶縁基板21の他面には、偏光子28が被着されている。偏光子15と28の透過軸は互いに離間して直交している。
40

【0004】

図示矢印方向のバックライト光がこの液晶表示パネルに入射すると、偏光子28を通って直線偏光になる。面電極12、コモン電極23及び画素電極25が同電位のとき、この直線偏光の偏光面は液晶30内で変化しないので、偏光子15を透過できず、暗状態にな
50

る。

【0005】

図32に示す如く、面電極12とコモン電極23とを同電位にし、画素電極25を上記電位と異なる電位にすると、電界が生ずる。図32中の点線は、電気力線を示している。この電界により、入射光の方向に対し液晶分子が傾くので、複屈折が生じ、この光の一部が偏光子15を透過して、明状態になる。

【0006】

コモン電極23及び画素電極25は遮光性のメタルであり、これらの上方の液晶分子の挙動は表示上問題にならない。

【0007】

面電極12が存在しないと、画素電極25とコモン電極23との中間の液晶分子の傾斜が小さくなつて透過率が落ち込む領域が存在する。面電極12はこの部分の横電界を斜め非対称にして透過率落込を防止するのに寄与する。誘電体13は、液晶30中の横電界を強化して、より低い印加電圧で液晶を駆動可能にするためのものである。コモン電極23と画素電極25とは、紙面垂直方向に延び且つ交互に形成されたストライプ電極である。絶縁層24は、コモン電極23と画素電極25とが後述のように上下に重なる部分で短絡するのを防止するためのものである。絶縁層26は焼付率を低減するためのものである。

【0008】

図33は、基板20に形成された電極パターンの1画素分を示す。図34及び図35はそれぞれ、図33中の画素電極25及びコモン電極23のパターン図である。

【0009】

データラインDL1と走査ラインSL1とは、絶縁膜を介して互いに直交している。画素電極25及びコモン電極23はいずれも、ストライプ部と、ストライプ部の端部を繋ぐ周囲部とを有する。ストライプ部は、走査ラインSL1及びデータラインDL1の各々に対し45°傾斜している。

【0010】

走査ラインSL1が高レベルになると、TFT29がオンになって、データラインDL1上の電圧が画素電極25に印加され、画素電極25とコモン電極23のストライプ電極間に電界が生ずる。ストライプ電極の長手方向は、図33の上半分と下半分とで互いに90°異なる。これにより、上半分と下半分とで互いに平行である場合よりも液晶表示パネルの視野角が広くなる。

【0011】

コモン電極23の周囲突起部は、不図示の隣の画素のコモン電極23に繋がっている。

【0012】

図36(A)は、図33中の線電極交差付近の部分拡大図である。図36(B)は、画素電極25とコモン電極23との間に電圧が印加された時の電気力線を点線で示す。

【0013】

画素が矩形であることと、画素電極25及びコモン電極23が互いに平行なストライプ部を有することと、画素電極25及びコモン電極23がいずれも一繋がりのものであることから、画素電極25の周囲部とコモン電極23の周囲部とは絶縁部を介し互いに重なる部分を有する。このため、画素電極25とコモン電極23の隣り合う線電極の端部が、絶縁部を介し交差する。例えば、画素電極25の辺251は、周囲部の辺252に繋がり、コモン電極23の辺231は、辺251と平行であるが辺252とは鋭角で交差している。

【0014】

図37は、液晶表示パネルの1画素の画素電極とコモン電極との間に電圧を印加した場合の電極間付近の液晶分子の傾斜を示す概略断面図である。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0015】

10

20

30

40

50

図32において、画素電極25と液晶30との間の構成が、コモン電極23と液晶30との間の構成と異なるので、焼付きが生ずる原因となる。

【0016】

また、図36(B)に示す如く、辺252と辺231とが鋭角で交差するので、この付近の電極間の電界が平行部分のそれよりも強くなる。さらに、交差付近の電界の方向が、平行部分のそれと異なる。このようなことから、交差付近の電極間印加電圧に対する透過特性が平行部分のそれと異なって、画質が劣化するとともに、焼付きが生ずる原因となる。

【0017】

さらに、図37において、画素電極25の上方に絶縁層26が存在するので、これらの部分に電界が印加されても無駄になり、液晶30に対し効率的に電界を印加することができない。垂直配向層27の絶縁性が低いので、この問題を解決するために絶縁層26を省略すると、焼付きが生ずる原因となる。液晶30に対し画素電極25を剥き出しにすると、さらに焼付きが大きくなるとともに、液晶分子が分解する。また、画素電極25の表面が平坦であるので、透過率との関係で液晶30に対し効率的に電界を印加することができず、表示の高コントラスト化が妨げられていた。

【0018】

液晶表示パネルの開発において、焼付率を所定値以下にするために、液晶表示パネルの構造や材料を変える毎に焼付率を測定すると、1回の測定に例えれば48時間要するので、開発期間が長くなる。

【0019】

本発明の目的は、このような点に鑑み、焼付率を低減可能な構造の液晶表示パネル及びその開発期間短縮化を可能にする液晶表示パネル開発方法を提供することにある。

【0020】

本発明の他の目的は、表示のコントラストを向上させることが可能な液晶表示パネルを提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0021】

本発明の参考に係る液晶表示パネルでは、第1基板と第2基板との間に液晶が封入され、上記第1基板は、絶縁基板と、上記絶縁基板の上方に形成された画素電極及びコモン電極を有する液晶表示パネルにおいて、上記第1基板及び上記第2基板には、それぞれ垂直配向膜を有し、上記第2基板の液晶側の主面には、面電極が形成され、上記絶縁基板の液晶側の面を基準として、上記画素電極の位置が上記コモン電極の位置よりも高く、上記画素電極と上記コモン電極とが第1絶縁膜を介して重なり合う部分を有し、上記画素電極と上記コモン電極とが上記第1絶縁膜を介して重なり合う部分により、上記画素電極の表面が凸形となっている。

【0022】

上記第1絶縁膜は、上記画素電極上と上記コモン電極上で厚みが実質的に同一であることが好ましい。上記画素電極が第2絶縁膜で覆われ、上記コモン電極と上記画素電極との間の表示領域に上記第2絶縁膜が実質的に形成されていないことが好ましい。

【0023】

上記画素電極及びコモン電極は、上記第1絶縁膜を介して互いに交差する部分を有し、上記画素電極及び上記コモン電極はいずれも、上記交差部分と連続する互いに平行な線電極部分を有し、上記交差部分の上記画素電極と上記コモン電極の隣り合う辺が互いに鈍角で交差していることが好ましい。

【0024】

本発明の液晶表示パネルでは、第1基板と第2基板との間に液晶が封入され、上記第1基板は、絶縁基板と、上記絶縁基板の上方に形成された画素電極及びコモン電極と、上記画素電極と上記コモン電極とを被う第1絶縁膜とを有する液晶表示パネルにおいて、上記絶縁基板の液晶側の面を基準として、上記画素電極の位置が上記コモン電極の位置よりも

10

20

30

40

50

高く、上記画素電極と上記コモン電極とが第2絶縁膜を介して重なり合う部分を有し、上記第1絶縁膜は、上記画素電極上と上記コモン電極上とで厚みが実質的に同一である。

【0025】

上記コモン電極は、上記絶縁基板上に形成され、上記画素電極は、上記コモン電極が形成された後に第2絶縁膜を介して形成され、上記第1絶縁膜は、上記画素電極の下方の部分以外の上記第2絶縁膜が除去された後に形成されていることが好ましい。

【0026】

本発明のさらに他の液晶表示パネルでは、第1基板と第2基板との間に液晶が封入され、上記第1基板は、透明絶縁基板と、上記透明絶縁基板の上方に形成され絶縁膜を介し互いに交差する部分を有する画素電極及びコモン電極とを備え、上記画素電極及び上記コモン電極はいずれも、上記交差部分と連続する互いに平行な線電極部分を有し、上記交差部分の上記画素電極と上記コモン電極の隣り合う辺が互いに鈍角で交差している。

10

【0027】

高さ方向を無視した平面上について、上記交差部分の上記隣り合う辺が、上記平行線分の間を通る直線に関し実質的に対称であることが好ましい。

【0028】

上記交差部分の上記隣り合う辺のいずれについても、上記絶縁基板の上下方向に関し上記画素電極の辺と上記コモン電極の辺とが重なっていないことことが好ましい。

20

【0029】

本発明の参考に係る液晶表示パネルの開発方法では、第1基板と第2基板との間に液晶が封入され、上記第1基板に画素電極が形成され、上記第1基板又は上記第2基板にコモン電極が形成された画素を有する液晶表示パネルに対するものであって、上記画素電極と上記コモン電極との間に交流電圧成分と直流電圧成分 V_{dc} の和である信号電圧を印加し、上記交流電圧成分の振幅 V_{ac} 及び上記直流電圧成分 V_{dc} を変化させて実質的に最適直流成分変動幅 V_{dc} を測定し、上記最適直流成分変動幅 V_{dc} が所定値以下になるように上記液晶表示パネルの構成又は構成材料を決定し、ここに、上記最適直流成分変動幅 V_{dc} は、 $V_{dc} = |V_{dcb} - V_{dcw}|$ と表され、 V_{dcb} は、上記振幅 V_{ac} を黒表示用交流電圧振幅に固定し上記直流電圧成分 V_{dc} を変化させた場合に、上記画素の透過率振幅が最小となる上記直流電圧成分 V_{dc} の値であり、 V_{dcw} は、上記振幅 V_{ac} を白表示用交流電圧振幅に固定し上記直流電圧成分 V_{dc} を変化させた場合に、上記画素の透過率振幅が最小となる上記直流電圧成分 V_{dc} の値である。上記所定値は 0.5 V 以下の値であることが好ましい。

30

【発明の効果】

【0030】

本発明の液晶表示パネルにより、第1及びコモン電極間に同一電圧を印加した場合に、画素電極の表面が平坦である場合よりも液晶分子をより傾斜させることが可能になり、表示のコントラストが向上する。

40

【0031】

本発明の他の液晶表示パネルによれば、画素電極とコモン電極との間に矩形交流電圧を印加した場合に、画素電極の上方とコモン電極の上方とで電気的状態がほぼ同一になって、例えば図31のように上記画素電極上と上記コモン電極上とで厚みが異なる場合よりも、焼付きが低減される。

【0032】

本発明のさらに他の液晶表示パネルによれば、鋭角で交差する場合よりも、電気力線の集中が緩和されて電界強度が大きくなるのが抑制され、表示画質が向上するとともに、焼付きが低減される。

【0033】

高さ方向を無視した平面上について、上記交差部分の上記隣り合う辺が、上記平行線分の間を通る直線に関し実質的に対称である場合には、電界ベクトルの方向が交差部分の電界ベクトルの方向が平行部分のそれと平行になるので、表示画質がさらに向上するとともに、焼付きがさらに低減される。

50

【0034】

本発明の参考に係る液晶表示パネル開発方法によれば、焼付率との相関度が高い最適直流成分変動幅 V_{dc} を短時間で容易に測定することができるので、最適直流成分変動幅 V_{dc} を用いることにより、焼付率が所望の値以下の液晶表示パネルを開発するための期間を短縮することが可能となる。

【0035】

焼付きを人が認識できないようにするために、焼付率を、室内の通常照明下の場合は 6 % 以下、暗室内的場合には 3 % 以下にしなければならない。

【0036】

上記所定値は、例えば 0 . 5 V 以下の値であり、上記所定値が 0 . 5 V のとき焼付率が 6 % 、上記所定値が 0 . 2 V のとき焼付率が 3 % であることを確認した。 10

【0037】

本発明の他の目的、構成及び効果は以下の説明から明らかになる。

【図面の簡単な説明】

【0038】

【図 1】本発明の参考に係る方法に用いられる液晶表示装置の概略回路図である。

【図 2】焼付率説明図である。

【図 3】画素印加電圧波形を示す図である。

【図 4】交流振幅 V_{ac} が 2 V 、直流成分 V_{dc} が - 3 V である場合の液晶画素透過率測定波形図である。 20

【図 5】交流振幅 V_{ac} が 2 V 、直流成分 V_{dc} が - 2 V である場合の液晶画素透過率測定波形図である。

【図 6】交流振幅 V_{ac} が 2 V 、直流成分 V_{dc} が - 1 V である場合の液晶画素透過率測定波形図である。

【図 7】交流振幅 V_{ac} が 2 V 、直流成分 V_{dc} が - 0 . 5 V である場合の液晶画素透過率測定波形図である。

【図 8】交流振幅 V_{ac} が 2 V 、直流成分 V_{dc} が 0 V である場合の液晶画素透過率測定波形図である。

【図 9】交流振幅 V_{ac} が 2 V 、直流成分 V_{dc} が 0 . 5 V である場合の液晶画素透過率測定波形図である。 30

【図 10】交流振幅 V_{ac} が 2 V 、直流成分 V_{dc} が 1 V である場合の液晶画素透過率測定波形図である。

【図 11】交流振幅 V_{ac} が 2 V 、直流成分 V_{dc} が 2 V である場合の液晶画素透過率測定波形図である。

【図 12】交流振幅 V_{ac} が 2 V 、直流成分 V_{dc} が 3 V である場合の液晶画素透過率測定波形図である。

【図 13】交流振幅 V_{ac} が 2 V である場合の、直流成分 V_{dc} と液晶画素透過率変動幅 T との関係の測定結果を示すグラフである。

【図 14】交流振幅 V_{ac} と液晶画素透過率変動幅 T が最小となる直流成分 V_{dc} との関係の測定結果を示すグラフである。 40

【図 15】焼付率と最適直流成分変動幅 V_{dc} との関係の測定結果を示すグラフである。

【図 16】本発明の第 1 実施形態の、焼付率を低減可能な液晶画素の構成の電圧無印加状態を示す概略断面図である。

【図 17】図 16 の液晶画素の電圧印加状態を示す概略断面図である。

【図 18】図 16 中の基板 20A の製造工程図である。

【図 19】本発明の第 2 実施形態の、焼付率を低減可能な液晶画素の電極パターン図である。

【図 20】図 19 中の画素電極のパターン図である。

【図 21】図 19 中のコモン電極のパターン図である。

【図 22】(A) は図 19 中の電極交差付近の拡大図であり、(B) は (A) の電極間に 50

電圧が印加された時の電気力線を点線で示す図である。

【図23】本発明の第3実施形態の、焼付率を低減可能な液晶画素の電極パターン図である。

【図24】図23中のコモン電極のパターン図である。

【図25】本発明の第4実施形態の、焼付率を低減可能な液晶画素の電極パターン図である。

【図26】図25中のコモン電極のパターン図である。

【図27】本発明の第5実施形態の、隣り合う2つの液晶画素の電極パターン図である。

【図28】図27中のA-A線に沿った断面拡大図である。

【図29】バックライト入射側基板の製造工程を示す図である。 10

【図30】図29の続きを示す製造工程図である。

【図31】本発明と対比される、液晶表示パネルの1画素の構造の電圧無印加状態を示す概略断面図である。

【図32】図31の画素の電圧印加状態を示す概略断面図である。

【図33】図32中の基板20に形成された電極パターンの1画素分を示す図である。

【図34】図33中の画素電極のパターン図である。

【図35】図33中のコモン電極のパターン図である。

【図36】(A)は図33中の電極交差付近の拡大図であり、(B)は(A)の電極間に電圧が印加された時の電気力線を点線で示す図である。

【図37】従来の液晶表示パネルの1画素の画素電極とコモン電極との間に電圧を印加した場合の電極間付近の液晶分子の傾斜を示す概略断面図である。 20

【発明を実施するための形態】

【0039】

以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。

【0040】

[参考形態]

最初に、焼付率を低減可能な構造又は材料を用いた液晶表示パネルの開発期間短縮化を可能にする液晶表示パネル開発方法を説明する。

【0041】

図1は、本発明の参考に係る方法に用いられる液晶表示装置の概略回路図である。図1では簡単化のために、画素アレイが3行6列の場合を示している。 30

【0042】

この回路自体は、従来と同一である。データラインDL1、走査ラインSL1、TFT29、画素電極25及びコモン電極23は、例えば図31に示す如く形成されている。画素電極25と対向する電極は、このコモン電極23と、図31に示す面電極12との両方である。走査ライン及びデータラインはそれぞれ、走査ドライバ31及びデータドライバ32の出力端に接続されている。制御回路33は、ピクセルクロックCLK及び水平同期信号H SYNCに基づいてデータドライバ32を制御するとともに、ビデオ信号VSをデータドライバ32に供給し、水平同期信号H SYNC及び垂直同期信号V SYNCに基づいて走査ドライバ31を制御する。走査ドライバ31により、画素アレイの行が順次選択され、選択された行にデータドライバ32から表示データ(階調電圧)が供給される。 40

【0043】

図2は、焼付率説明図である。

【0044】

例えば、表示データが64階調、「白」が第64階調、「黒」が第1階調である場合を考える。焼付率は次のようにして測定される。

【0045】

(A)白(第64階調)を表示させて輝度Bmを測定する。

【0046】

(B)次に、白と黒の固定パターンを例えば48時間表示させる。 50

【0047】

(C) この直後に中間調(第32階調)を表示させて、上記(B)で白を表示していた領域と黒を表示していた領域との輝度B_{mw}及びB_{mb}を測定する。焼付率は、次式で計算される。

【0048】

$$\text{焼付率} = 100 (B_{mw} - B_{mb}) / B_m$$

上記(C)において、焼付きを人が認識できないようにするために、焼付率を、室内的通常照明下の場合には6%以下、暗室内の場合には3%以下にしなければならない。

【0049】

焼付率は、液晶表示パネルの構造や構成材料により異なる。液晶表示パネルの開発において、焼付率を所定値以下にするために、液晶表示パネルの構造や材料を変える毎に焼付率を測定すると、1回の測定に例えれば48時間要するので、開発期間が長くなる。そこで、焼付率と相関度が高い物理量であって、短時間で測定できるものを探すことを考える。

10

【0050】

液晶画素には、その劣化を防止するために矩形交流電圧が印加される。図3は、図32の画素電極25とコモン電極23との間及び画素電極25と面電極12との間に印加される電圧波形を示す。周波数は30Hzである。

【0051】

交流電圧印加によりフリッカが生ずるのを防止するため、すなわち透過率が周期的に変化するのを防止するために、液晶画素印加電圧には直流電圧成分が加えられる。矩形交流電圧の振幅及び直流電圧成分をそれぞれV_{ac}及びV_{dc}で表す。

20

【0052】

交流振幅V_{ac}を固定し、直流成分V_{dc}を段階的に変化させた場合の液晶表示パネル透過率を測定した。図4～図12は、交流振幅V_{ac}を黒表示用電圧である2Vに固定し、直流成分V_{dc}を-3V、-2V、-1V、-0.5V、0V、0.5V、1V、2V及び3Vにした場合のそれぞれの透過率変動を示す。図4に示す如く、透過率変動幅をTで表す。

【0053】

図13は、V_{ac}=2Vの場合の直流成分V_{dc}と透過率変動幅Tとの関係を示すグラフである。このグラフから、透過率変動幅Tが最小となる直流成分V_{dc}の値は-0.38Vと推定される。

30

【0054】

さらに、交流振幅V_{ac}が白表示用電圧である7Vと中間調表示用電圧(2+7)/2=4.5Vの場合に、透過率変動幅Tが最小値T_{min}となる直流成分V_{dc}を上記同様にして求めた。これらの結果を、図14に示す。交流振幅V_{ac}が白表示用電圧と黒表示用電圧であるときの直流成分V_{dc}の差をV_{dc}で表す。実際の液晶表示装置では直流成分V_{dc}が固定値であるので、最適直流成分変動幅V_{dc}が狭いほどフリッカが弱くなる。

【0055】

図15は、液晶表示パネルの構造や材料を変えて焼付率及び最適直流成分変動幅V_{dc}を測定し、両者の関係を表したグラフである。このグラフから、焼付率と最適直流成分変動幅V_{dc}との相関度が高いことが判る。また、焼付率が上記6%以下であるためには、最適直流成分変動幅V_{dc}が0.5V以下でなければならず、焼付率が上記3%以下であるためには、最適直流成分変動幅V_{dc}が0.2V以下でなければならないことが判る。

40

【0056】

最適直流成分変動幅V_{dc}は短時間で容易に測定することができるので、V_{dc}を用いることにより、焼付率が所望の値以下の液晶表示パネルを開発するための期間を大幅に短縮することが可能となる。

【0057】

なお、図31において、面電極12を用いずに、画素電極25とコモン電極23を用いた構成、及び、コモン電極23を用いずに、画素電極25と面電極12とを用いた構成で

50

あっても、最適直流成分変動幅 V_{dc} と焼付率との相関度は高く、その他の構成の液晶表示パネルについても同様の相関関係があると考えられる。

【0058】

[第1実施形態] 図16及び図17はいずれも、焼付率を低減可能な本発明の第1実施形態の液晶画素の構成を示す概略断面図である。図16は電圧無印加時の状態を示し、図17は電圧印加時の状態を示す。

【0059】

この画素を有する液晶パネルは、基板20Aの構成が図22の基板20のそれと異なっている。他の構成は、図22のそれと同一である。

【0060】

図18は、基板20Aの製造工程図である。図18中、右端部はコモン電極23Aと画素電極25Aとが絶縁層24Aを介し重なっている部分に関する。

【0061】

(A) フォトリソグラフィー技術により、透明絶縁基板21上にメタルのコモン電極23Aが形成される。

【0062】

(B) 透明絶縁基板21上に絶縁層24が被着される。

【0063】

(C) フォトリソグラフィー技術により、絶縁層24上に画素電極25Aが形成される。

【0064】

(D) 画素電極25Aをマスクとして絶縁層24がエッチングされ、画素電極25Aの真下の部分のみ絶縁層24Aが残される。

【0065】

(E) 透明絶縁基板21上に絶縁層26Aが被着される。

【0066】

(F) 絶縁層26A上に垂直配向層27が積層される。

【0067】

このようにして基板20Aを形成することにより、画素電極25A上の絶縁層26Aの厚みとコモン電極23A上の絶縁層26Aの厚みとが実質的に同一になるので、図17に示す如く画素電極25Aとコモン電極23Aとの間に矩形交流電圧を印加した場合に、コモン電極23Aの上方と画素電極25Aの上方とで電気的状態がほぼ同一になって、図31の構成の液晶表示パネルよりも焼付きが低減される。換言すれば、図15の最適直流成分変動幅 V_{dc} がより小さくなって、焼付率が低くなる。

【0068】

絶縁層24A及び26Aは例えば、SiNx、SiO₂、レジスト又はアクリル樹脂のいずれかである。試作においては、絶縁層24A及び26AとしてSiNxを用い、垂直配向層27としてJALS204(JSR社)を用い、液晶30としてZLI4535(メルク・ジャパン社)を用い、試作品の焼付率低減効果が確認された。

【0069】

[第2実施形態] 図19は、焼付率を低減可能な、本発明の第2実施形態の液晶画素の電極パターン図であり、図33と類似している。

【0070】

この電極パターンは、例えば図16の基板20A又は図31の基板20に形成されている。

【0071】

図20及び図21はそれぞれ、図19中の画素電極25A及びコモン電極23Aのパターン図であり、それぞれ図34及び図35と類似している。

【0072】

画素が矩形であることと、画素電極25A及びコモン電極23Aが互いに平行なストラ

10

20

30

40

50

イブ部を有することと、画素電極 25A 及びコモン電極 23A がいずれも一繋がりのものであることから、画素電極 25A の周囲部とコモン電極 23A の周囲部とは、絶縁膜を介し互いに重なる部分を有する。このため、画素電極 25A とコモン電極 23A の隣り合う線電極の端部が、絶縁部を介し交差する。例えば、画素電極 25A の辺 251 とコモン電極 23A の辺 231 とは互いに平行であり、辺 251 及び辺 231 にそれぞれ連続する辺 252 と辺 232 とが交差する。

【0073】

図 22(A) は、この電極交差付近の拡大図である。図 22(B) は、画素電極 25A とコモン電極 23A との間に電圧が印加された時の電気力線を点線で示す。

【0074】

辺 252 と辺 232 とが鈍角で互いに交差しているので、図 36(A) に示すように辺 252 と辺 231 とが鋭角で交差する場合よりも、電気力線の集中が緩和されて電界強度が大きくなるのが抑制される。

【0075】

また、辺 251 と辺 231 との間を通る線 SA に関し辺 251 及び 252 と辺 231 及び 232 とが対称になっている。これにより、辺 252 と辺 232 の間の電界ベクトルの方向は、辺 251 と辺 231 の間のそれと平行になる。

【0076】

このようなことから、電極交差付近の透過特性の急変分布が緩和されて、表示画質が向上するとともに、焼付きが低減される。他の電極交差付近についても上記同様である。

【0077】

電極パターン以外は上記試作例と同一にして、図 19 の電極パターンを用いた液晶パネルと図 33 の電極パターンを用いた液晶パネルとを試作し、図 19 の電極パターンを用いた液晶パネルの方が焼付率が低くなることを確認した。

【0078】

[第3実施形態] 図 23 は、焼付率を低減可能な、本発明の第3実施形態の液晶画素の電極パターン図であり、図 19 と類似している。図 24 は、図 23 中のコモン電極 23B のパターン図である。画素電極 25A は、図 20 のそれと同一である。

【0079】

コモン電極 23B の周囲部には、コモン電極 23B の一体性を確保しつつ切除部 23B 1 ~ 23B 8 が形成されている。これら切除部 23B 1 ~ 23B 8 の位置は、コモン電極 23B と画素電極 25D の、絶縁体を介した交差部付近である。

【0080】

この切除部が無い場合には、電圧印加時にこの部分と画素電極 25A との間の非表示領域で電界が生じてその付近の表示領域の液晶分子の配列に影響を与える。切除部によりこの影響がなくなるので、上記第3実施形態の場合よりも表示画質が向上すると共に、焼付きが低減される。

【0081】

[第4実施形態] 図 25 は、焼付率を低減可能な、本発明の第4実施形態の液晶画素の電極パターン図であり、図 33 と類似している。図 26 は、図 25 中のコモン電極 23C のパターン図である。画素電極 25 は、図 34 のそれと同一である。

【0082】

コモン電極 23C は、図 24 の場合と同様に、コモン電極 23C の一体性を確保しつつ切除部 23B 1 ~ 23B 8 が形成されている。これにより、図 23 の構成と比べて、上記第4実施形態と同じ理由で表示画質が向上すると共に、焼付きが低減される。

【0083】

[第5実施形態] 図 27 は、本発明の第5実施形態の、隣り合う 2 つの液晶画素の電極パターン図である。両画素は、同一パターンを有する。

【0084】

コモン電極 23D と画素電極 25D の枠部は、絶縁膜を介し互いに重なっている。画素

電極 25D のストライプ電極の下方及び線電極間の下方に、コモン電極 23D のストライプ電極部が形成されており、その線密度は画素電極 25D のそれの 2 倍である。

【0085】

図 28 は、図 27 中の A - A 線に沿った断面拡大図である。

【0086】

図 32 の液晶画素と異なる点は、画素電極 25D の線電極部が凸形であることと、絶縁層 26D が画素電極 25D 上のみに形成され、コモン電極 23D と画素電極 25D の線電極間表示領域に絶縁層が形成されていないことである。垂直配向層 27 は絶縁層 26D よりも薄いので、図 28 ではこれを太線で示している。

【0087】

画素電極 25D の線電極部が凸形であることから、その面が中央線から両側へ傾斜している。上記凸形に形成するために、図 32 と異なり、画素電極 25D の線電極部下方にも、画素電極 25D の線電極部より細幅の、コモン電極 23D の線部が形成されている。この凸形を強調するために、図 27 の TFT29 を作る時に形成されるチャンネル保護膜 31 が、コモン電極 23D の線部上方に残されている。チャンネル保護膜 31 の幅は、コモン電極 23D の線部のそれよりも細い。

【0088】

これにより、画素電極 25D の線電極部が土手形となるので、画素電極 25D とコモン電極 23D との間に電圧を印加した場合に、電気力線が図 28 中の点線で示すようになる。すなわち、画素電極 25D の傾斜面付近の電気力線がこの面に垂直になるので、液晶分子の傾斜が、透明絶縁基板 21 の面の法線に対しより大きくなり、図 32 の場合よりも白表示の透過率が増す。したがって、表示のコントラストが向上する。

【0089】

また、画素電極 25D と絶縁層 26D のパターンが同一で画素電極 25D とコモン電極 23D の間の表示領域に絶縁層 26D が存在しないので、図 32 の場合よりも液晶分子に対し電界が有効利用され、同じ印加電圧の場合に図 32 の場合よりもコントラストが向上する。

【0090】

さらに、液晶が画素電極 25D に直接接触しないので、液晶の分解が防止されると共に、焼付きが低減される。

【0091】

図 29 及び図 30 は、基板 20D の製造工程を示す。各図は、図 27 中の B - B 線に沿った断面に対応している。次に、これについて説明する。

【0092】

(A) フォトリソグラフィ技術により、透明絶縁基板 21 上にメタルのコモン電極 23D 及び走査(ゲート)ライン SL1 が形成される。

【0093】

(B) 透明絶縁基板 21 上に絶縁層 24、真性半導体膜 32 及びチャンネル保護膜 31 が積層される。フォトリソグラフィ技術により、走査ライン SL1 とコモン電極 23D の上方のみにチャンネル保護膜 31 が残される。

【0094】

(D) 半導体膜 32 上に n+ 半導体膜 33、導電膜 25D 及び絶縁層 26D が積層され、これらが同一パターンで食刻されて、走査ライン SL1 の上方に TFT29 のソース S とドレイン D とが形成されると同時に、コモン電極 23D の線部上方に、画素電極 25D の線電極部及び絶縁層 26D が形成される。画素電極 25D 並びに TFT29 の電極は、3 層の導電膜 25a、25b 及び 25c で形成されている。導電膜 25a ~ 25c は例えば、Ti / Al / Ti である。電極 25D として Al 膜のみ用いるところが n+ 半導体膜 33 内に拡散するので、これを避けるために Ti 膜が用いられ、Ti 膜のみ用いると抵抗率が高くなるので、Al 膜も用いられている。絶縁層 26D は、DVD で形成される窒化シリコン膜又は酸化シリコン膜である。

10

20

30

40

50

【0095】

なお、画素電極 25D として 2 層の Ti / Al を用い、絶縁層 26D として窒化アルミニウムを用いれば、スパッタ装置でこれらを連続的に成膜することができるので、工程数が削減される。また、絶縁層 26D としては、パターニングで用いられるフォトレジストを残存させたものであってもよい。

【0096】

(E) 絶縁層 24 上及び 26 上に、太線で示す垂直配向層 27 が被着される。

【0097】

本第 6 実施形態によれば、画素電極 25D の土手形線電極部及びその上の絶縁層 26D が TFT 29 と同時に形成されるので、画素電極 25D 及び絶縁層 26D を形成するために工程数を増加する必要がない。

10

【符号の説明】

【0098】

10、20、20A 基板

11、21 透明絶縁基板

12 面電極

13 誘電体

14、27 垂直配向層

15、28 偏光子

23、23A～23D コモン電極

20

231、232、251、252 迂

23B1～23B8 切除部

24、24A、26、26A、26D 絶縁層

25、25A、25D 画素電極

25a～25c 導電膜

29 TFT

30 液晶

31 チャンネル保護膜

32 半導体膜

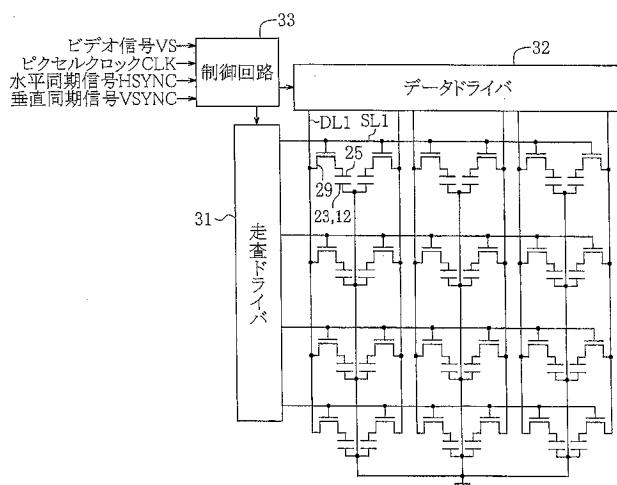
33 n+半導体膜

30

D L 1 データライン

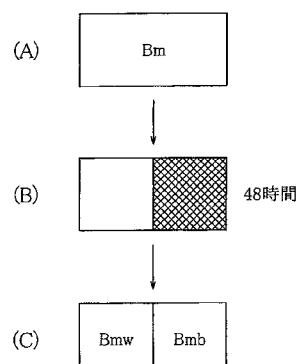
S L 1 走査ライン

【図1】



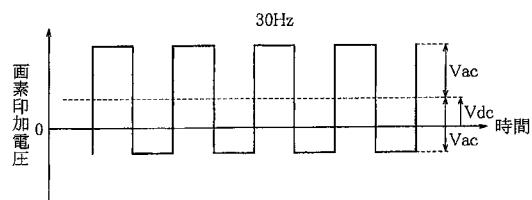
【図2】

焼付率説明図

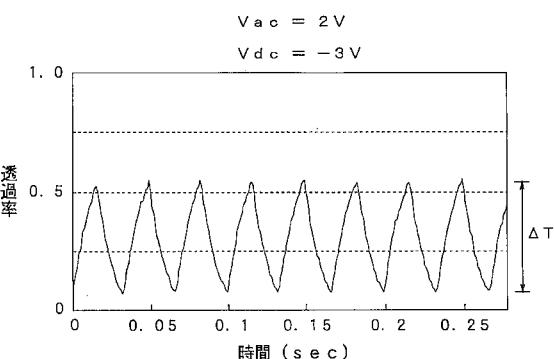


【図3】

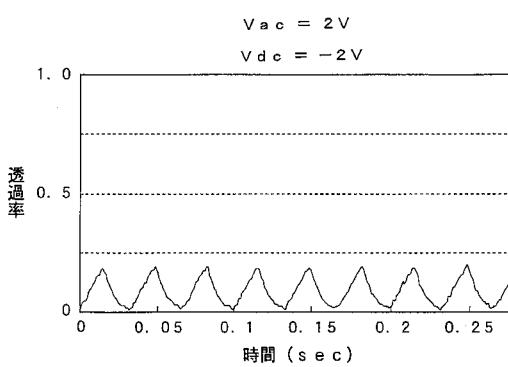
画素印加電圧波形を示す図



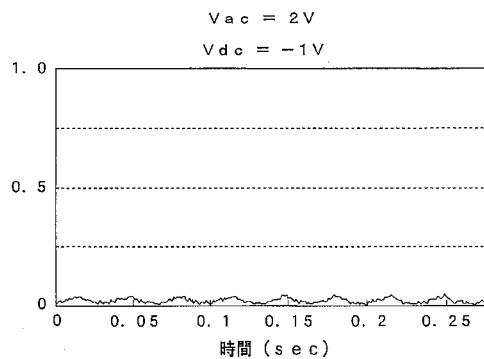
【図4】



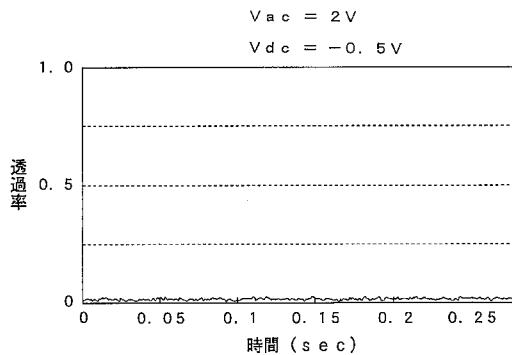
【図5】



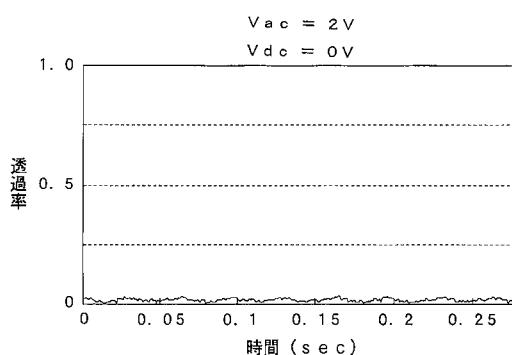
【図6】



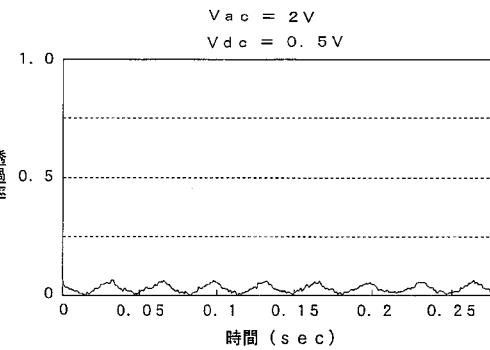
【図7】



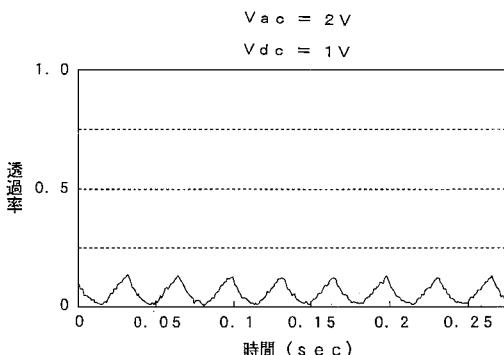
【図8】



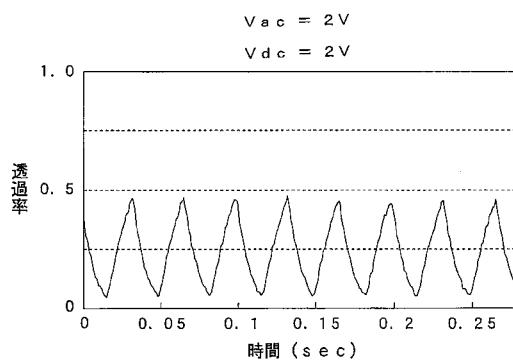
【図9】



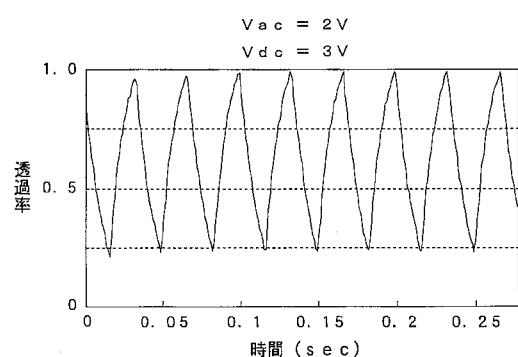
【図10】



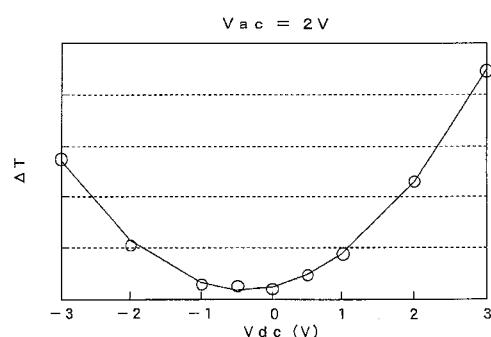
【図11】



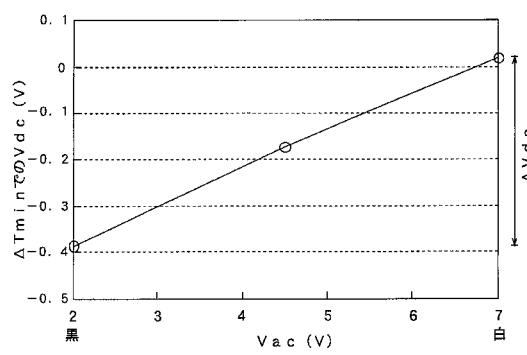
【図12】



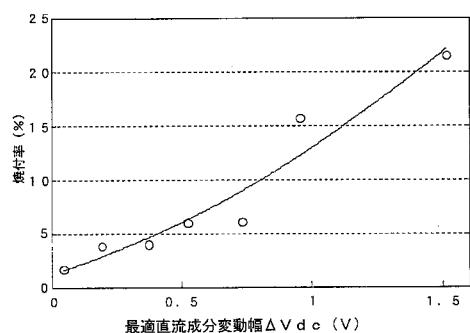
【図13】



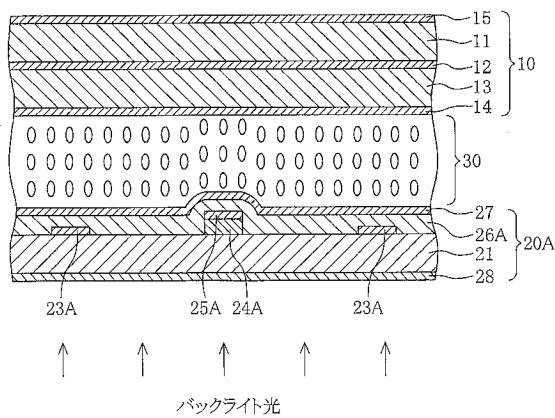
【図14】



【図15】

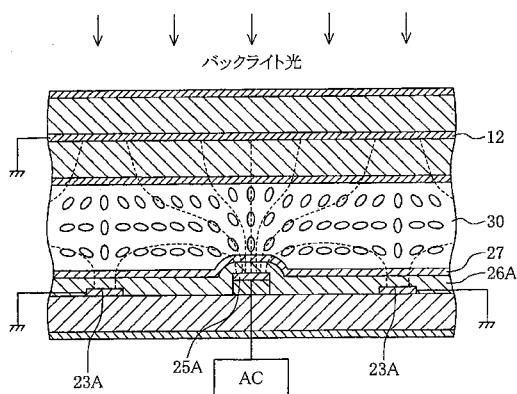


【図16】



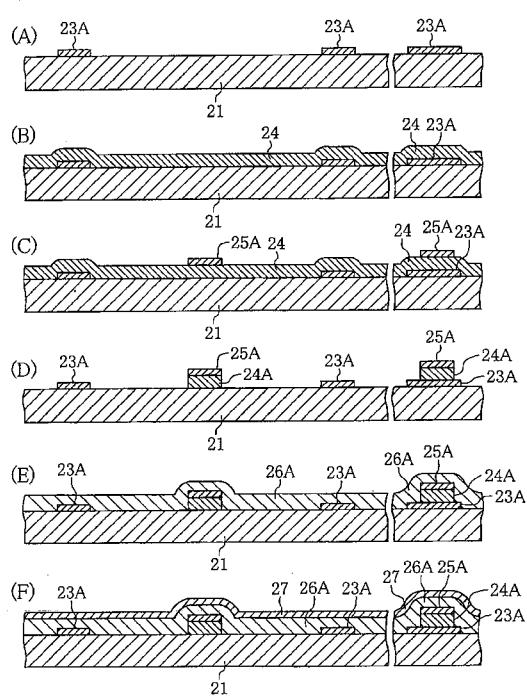
【図17】

図16の液晶画素の電圧印加状態を示す概略断面図

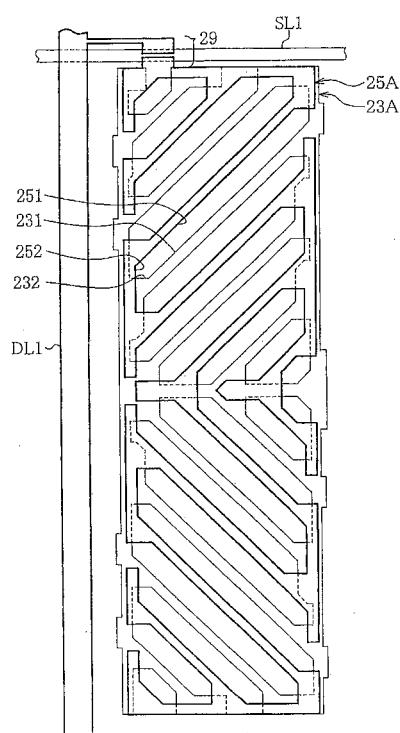


【図18】

図16中の基板20Aの製造工程図

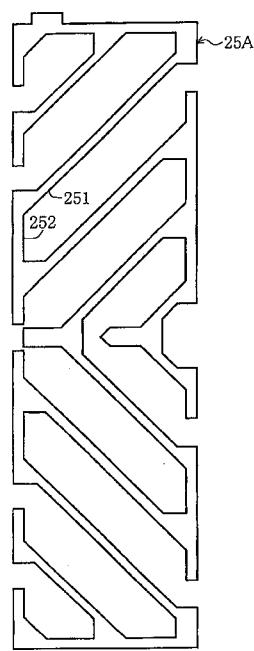


【図19】



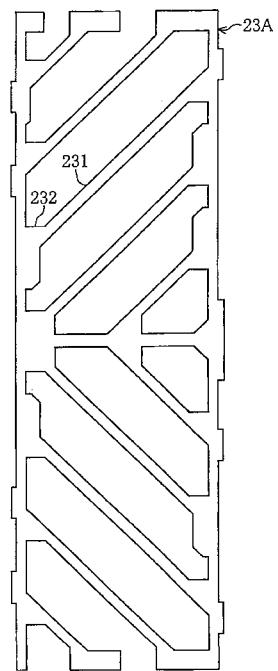
【図 2 0】

図19中の画素電極のパターン図



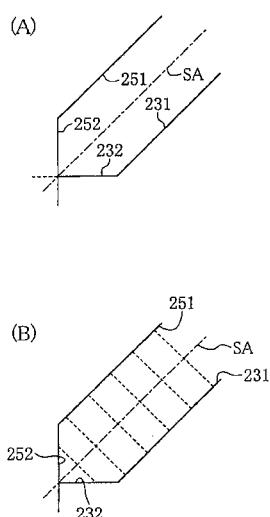
【図 2 1】

図19中のコモン電極のパターン図

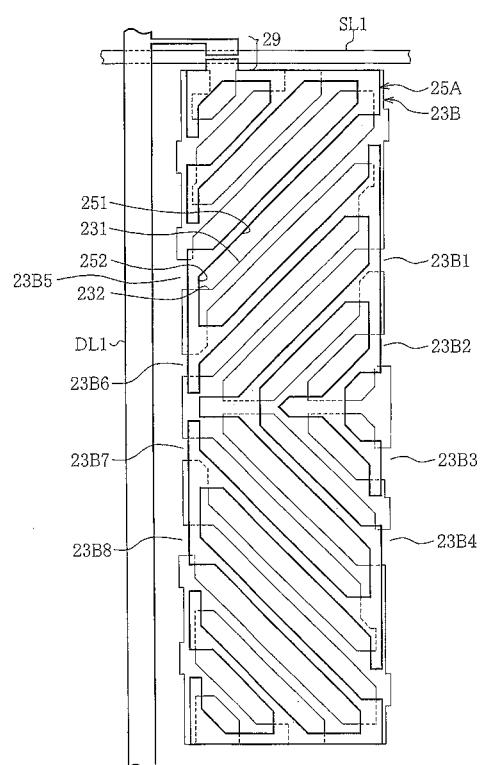


【図 2 2】

(A)は図19中の電極交差付近の拡大図であり、
(B)は(A)の電極間に電圧が印加された時の
電気力線を点線で示す図

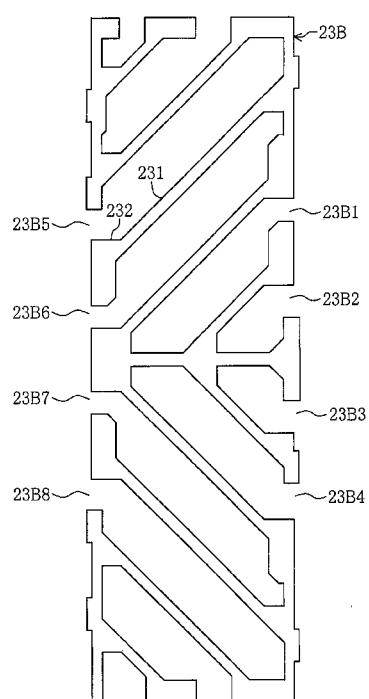


【図 2 3】

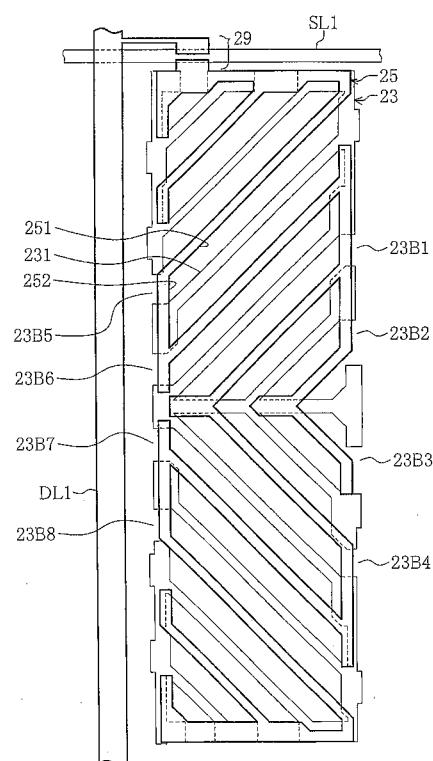


【図24】

図23中のコモン電極のパターン図

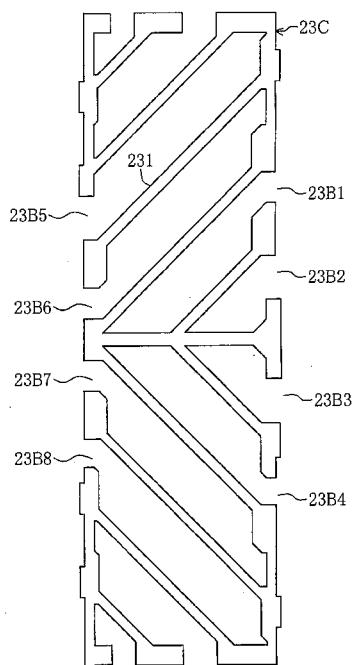


【図25】

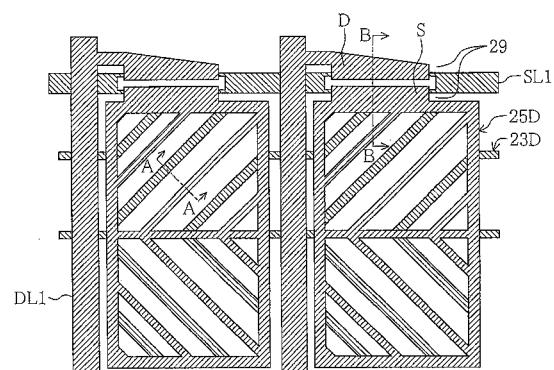


【図26】

図25中のコモン電極のパターン図

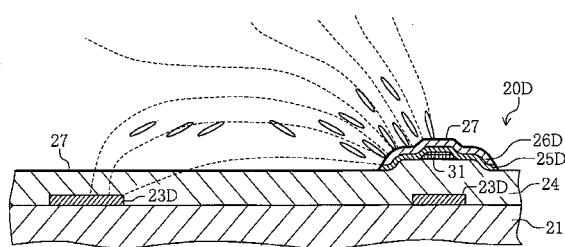


【図27】



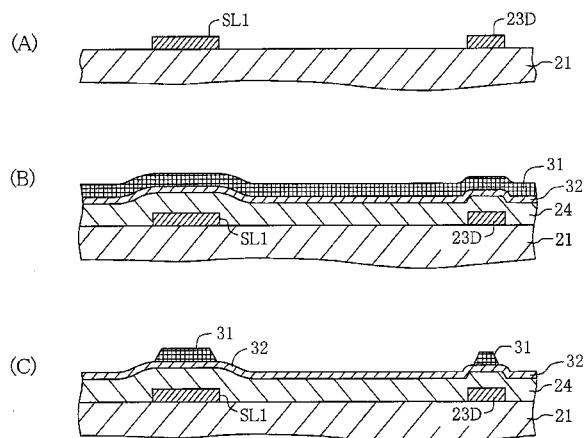
【図28】

図27中のA-A線に沿った断面拡大図



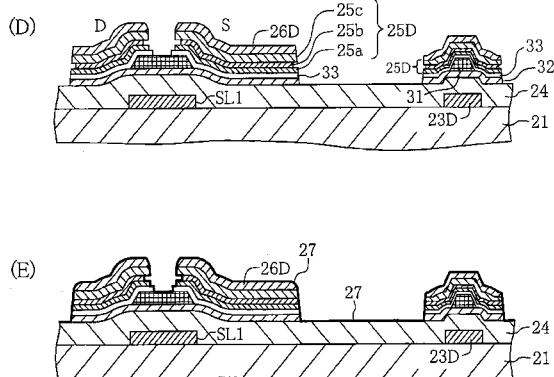
【図29】

バックライト入射側基板の製造工程を示す図



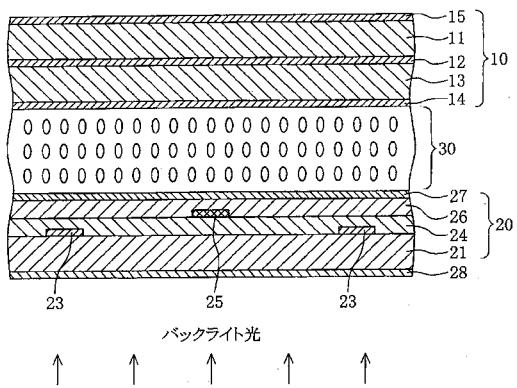
【図30】

図29の続きを示す製造工程図



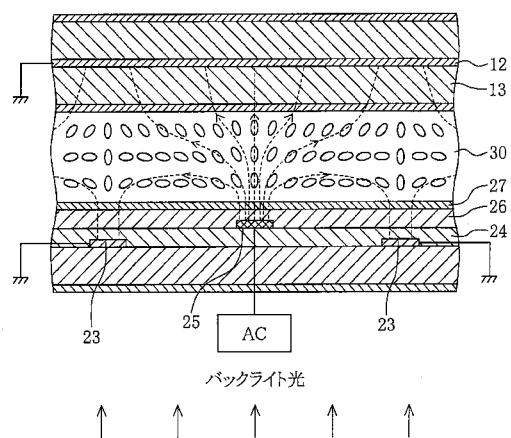
【図31】

本発明と対比される、液晶表示パネルの1画素の構造の電圧無印加状態を示す概略断面図



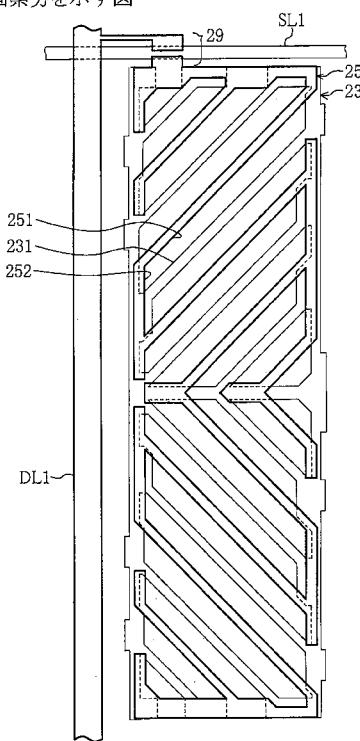
【図32】

図31の画素の電圧印加状態を示す概略断面図



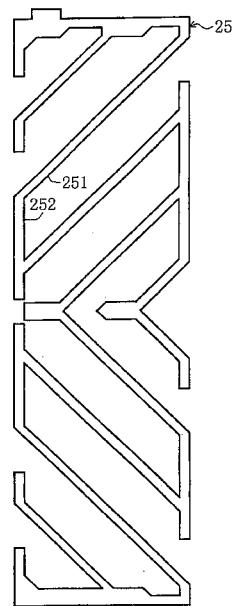
【図33】

図32中の基板20に形成された電極パターンの
1画素分を示す図



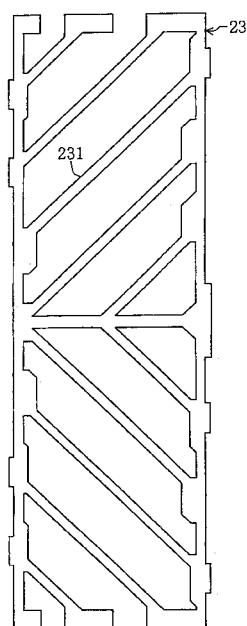
【図34】

図33中の画素電極のパターン図



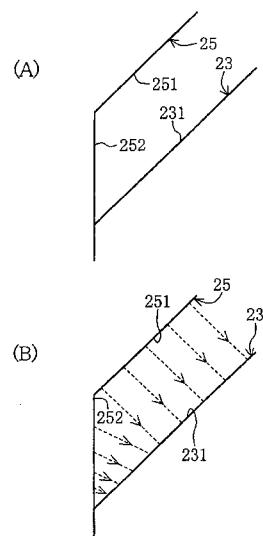
【図35】

図33中のコモン電極のパターン図



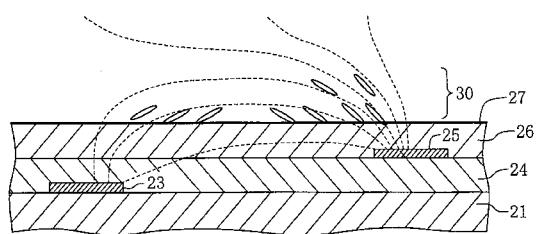
【図36】

(A)は図33中の電極交差付近の拡大図であり、
(B)は(A)の電極間に電圧が印加された時の
電気力線を点線で示す図



【図 3 7】

従来の液晶表示パネルの1画素の画素電極と
コモン電極との間に電圧を印加した場合の電極
間付近の液晶分子の傾斜を示す概略断面図



フロントページの続き

(72)発明者 田坂 泰俊
神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内

(72)発明者 藤川 徹也
神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内

(72)発明者 助則 英智
神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通株式会社内

F ターム(参考) 2H092 GA14 JA24 JB05 JB14 JB57 MA05 MA07 MA13 MA17 NA01

专利名称(译)	液晶显示面板		
公开(公告)号	JP2012073640A	公开(公告)日	2012-04-12
申请号	JP2011259628	申请日	2011-11-28
[标]申请(专利权)人(译)	夏普株式会社		
申请(专利权)人(译)	夏普公司		
[标]发明人	仲西洋平 吉田秀史 笹林貴 田坂泰俊 藤川徹也 助則英智		
发明人	仲西 洋平 吉田 秀史 笹林 貴 田坂 泰俊 藤川 徹也 助則 英智		
IPC分类号	G02F1/1343		
FI分类号	G02F1/1343		
F-TERM分类号	2H092/GA14 2H092/JA24 2H092/JB05 2H092/JB14 2H092/JB57 2H092/MA05 2H092/MA07 2H092/MA13 2H092/MA17 2H092/NA01		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

解决的问题：提供一种具有能够降低燃烧速率的结构的液晶显示装置。液晶显示面板具有在透明绝缘基板（21）的与液晶（30）相对的面上形成的像素电极（25A）和公共电极（23A），在透明绝缘基板（11、21）之间封入有液晶（30）。25A和公共电极23A经由第二绝缘膜24A彼此重叠，并且在像素电极25A和公共电极23A上，第一绝缘膜26A具有基本相同的厚度。[选择图]图16

